

Excerpt Translation

Reference Number OG004237

Mailing Number 198998

Mailing Date 2003 June 10

OFFICIAL NOTICE OF REASON FOR REJECTION

Patent Application Number	1999 Patent Application No.369811
Date of Draft	2003 June 4
JPO Examiner	KYOICHI SAITOH 8122 4L00
Agent of Patent Applicant	KENJI OHNISHI
Applied Articles	Article 29-Paragraph 1, Article 29 Paragraph 2, Article 36

This application is to be rejected for the following reason. The argument should be submitted within 60 days of the mailing date of this official notice.

REASON

1. Since the inventions as defined in the following Claims of the present application indicate the inventions described in the following publications disseminated in Japan or foreign countries before the application thereof, the inventions correspond to the third of the first paragraph of Article 29 and hence a patent may not be obtained.

2. The invention in accordance with the following claims of this application shall not be granted a patent on the basis of Section 29 (2) of the Patent Law, because the invention could easily have been made by a person with ordinary skill in the art to which the invention pertains on the basis of an invention or inventions referred to inventions which were described in the following publication distributed in Japan or elsewhere prior to the filing of the patent application.

•
•
•

NOTE (Referring to a list of cited references with regard to cited references)

<For REASONS 1,2>

Claims 1-7, 11-17

- Reference Cited: Documents 1-3
- Remarks:

(For claims 1, 6, 7, 11, 13, 14, 17)

The Document 1(see Fig. 1 etc) .is described that a dummy pattern is formed at a outside of a citcuit formed region to prevent moisture intrusion in a hygroscopic insulating film of a side of the circuit formed region.

Additionally, the Document 1 is described to parform overall etch-back the hygroscopic insulating film.

(For claims 2-4, 15, 16)

It could easily have been made by a person with ordinary skill in the art to change the dummy pattern of the outside of the circuit formed region in the Document 1 to double dummy patterns, because the Ducment 2(see Fig.5) is described that a dummy pattern is formed to double surrounding for heightenning an effect of preventing the moisture intrusion.

(For claims 5, 12)

The invention according to claims 5 and 12 is taken up the invention related a pad portion of a fifth embodiment in the present invention, it is known a technical problem that a SOG film is exposed at an opening of the pad portion, and the Document 2 is described that the dummy pattern is formed to prevent exposing SOG etc at a opening of a semiconductor device.

Accordingly, it could easily have been made by a person with ordinary skill in the art to form the dummy pattern as surrounding the pad portion formed the opening.

•
•
•

List of Cited References

1. Japanese Patent Publication Laid-Open No. Hei 07(1995)-161706
 2. Japanese Patent Publication Laid-Open No. Hei 09(1997)-139431
 3. Japanese Patent Publication Laid-Open No. Hei 10(1998)-178011
-

Record of search results on prior art documents

Searched Field: IPC Seventh Edition

H01L21/3205-21/3213

H01L21/768

拒絶理由通知書

特許出願の番号 平成11年 特許願 第369811号
起案日 平成15年 6月 4日
特許庁審査官 齋藤 恭一 8122 4L00
特許出願人代理人 大西 健治 様
適用条文 第29条第1項、第29条第2項、第36条



この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
3. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・理由 1又は2
- ・請求項 1-7, 11-17
- ・引用文献等 1-3
- ・備考

(請求項1, 6, 7, 11, 13, 14, 17について)

引用例1(図1等を参照)には、回路形成領域の外側にダミーパターンを形成し、回路形成領域側の吸湿性絶縁膜への水分侵入を防止することが記載されている。

なお、引用例1には、吸湿性絶縁膜を全面エッチバックすることも記載されて

S i S C

提出期限
8.月11日

いる。

(請求項2-4, 15, 16について)

引用例2(図5を参照)には、水分侵入防止効果を高めるために、ダミーパターンを2重に囲むように形成することが記載されているから、引用例1記載の回路形成領域外側のダミーパターンを2重にすることは、当業者が容易に想到し得ることと認められる。

(請求項5, 12について)

請求項5, 12に係る発明は、本願第5実施例のパッド部に関する発明と解されるが、引用例3に記載されるように、パッド部の開口でSOG膜が露出するという技術課題は周知のものであり、また、引用例2には、半導体装置の開口部においてSOG等が露出されるのを防止するために、ダミーパターンを形成することが記載されている。

したがって、開口が形成されるパッド部を囲むようにダミーパターンを形成することは、当業者が容易に想到し得ることと認められる。

・理由 3

(1) 各請求項において、第2(又は第3)の絶縁膜とその状態が明示されておらず、技術課題と対応した発明の構成が不明瞭である。

[少なくとも、第2(又は第3)の絶縁膜がSOG膜であることと、回路形成領域側のSOG膜が半導体基体のエッジのSOG膜と遮断(分離)されていることは、発明特定事項として必須のものと認められる。]

(2) 請求項8の第7行及び請求項18の第8行の「ダミーパターン」は不明瞭な記載である。

よって、各請求項に係る発明は明確でない。

引用文献等一覧

1. 特開平07-161706号公報
2. 特開平09-139431号公報
3. 特開平10-178011号公報

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 H01L21/3205～21/3213
H01L21/768

発送番号 198998

発送日 平成15年 6月10日 3 / 3

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。